








	<h2>SI8902EDB-T2-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8902EDB-T2-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 3.9A 6-MFP</p> <p>Datenblätter:  SI8902EDB-T2-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 164438 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8902EDB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 3.9A 6-MFP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	164438 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Common Drain 20V
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1W
Verpackung / Gehäuse	6-MICRO FOOT@CSP
Supplier Device-Gehäuse	6-Micro Foot™ (1.5x1)
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 980µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI8902
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8902EDB-T2-E1TR

SI8902EDB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8902EDB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8902EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8902EDB-T2-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8902EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 3.9A 6-MFP</p>	 <p>SI8904EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 3.8A 6-MFP</p>	 <p>SI8902D-A01-GSR Energy Micro (Silicon Labs) IC ADC 10BIT SPI/SRL SOIC</p>	 <p>SI8902EDB VISHAY SI8902EDB VISHAY</p>
 <p>SI8902EDB-T2 VISHAYN SI8902EDB-T2 VISHAYN</p>	 <p>SI890XPWR-KIT Energy Micro (Silicon Labs) KIT REF DESIGN FOR SI890X ADC</p>	 <p>SI8920AC-IPR Energy Micro (Silicon Labs) IC OP AMP ISOLATION 8DIP-GW</p>	 <p>SI8904EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 3.8A 6-MFP</p>

heiße Teile

Mehr

SI8640EC-B-IS	SI8640ED-B-IS	SI8641BB-B-IS	SI8641BC-B-IS	SI8641BD-A-ISR
SI8641BD-B-IS	SI8641BD-B-ISR	SI8641EC-B-IS	SI8641ED-B-IS	SI8641ED-B-ISR
SI8642AB-B-ISR	SI8642BC-B-IS1	SI8645BB-B-IS	SI8645BC-B-IS	SI8645BD-B-IS
SI8660AB-B-IS1	SI8660BA-A-IS1R	SI8661BD-B-ISR	SI8662AB-B-IS1	SI8662BC-A-IS1R
SI8710AC-B-IS	SI8710AD-B-IS	SI8710BD	SI8710CC-B-IP	SI8710CC-B-IS
SI8710CD-B-IS	SI8710CD-B-ISR	SI8711CC-B-IS	SI8712AC-B-IS	SI8716BC
SI8716BC-A-IS	SI8719BD-A-IS	SI8800EDB-T2-E1	SI8800EDB-T2-E1	SI8802DB-T2-E1
SI8802DB-T2-E1	SI8808DB-T2-E1	SI8808DB-T2-E1	SI8812DB-T2-E1	SI8812DB-T2-E1
SI8901EDB-T2	SI8901EDB-T2-E1	SI8901EDB-T2-E1	SI8902EDB	SI8902EDB-T2
SI8902EDB-T2-E	SI8902EDB-T2-E1	SI8920AC-IP	SI8920BC-IPR	SI8920BC-IPR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited